⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 183881

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号	四公開	昭和62年(1987)8月12日
B 05 D 1/20 B 29 D 7/01 C 08 J 5/18 H 01 L 21/312 21/368 29/28 29/62	CFJ	7180-4F 6660-4F 8115-4F 6708-5F 7739-5F 6835-5F	C - 1.0.1	
29/78		8422-5F	審査請求 有	発明の数 3 (全13頁)

砂発明の名称 複素芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

②特 顧 昭61-24219

❷出 願 昭61(1986)2月7日

砂発 明 者 アラン・ケント・エン 東京都杉並区阿佐谷北4-28-14

ゲル

①出 願 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

邳代 理 人 弁理士 大多和 明敏

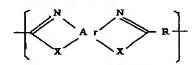
明 舞音

1. 恐明の名称

推案芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)推购芳香族排造

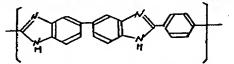


(式中、Arは芳香族植、XはNR', S, O, SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R' はH, 芳香族基もしくは脂肪袋基であり、Rは芳

香袋基、複素労呑袋基、飽和もしくは不飽和酸肪 総装である)

を含有する投票券番談窩分子化合物を主要構成要 業とする超帯譲で、該港膜は1もしくはそれ以上 の単層からなるか、該単層の1もしくはそれ以上 を含有する程度多層からなるものであることを特 数とする超遊膜。

(2)権兼原子のXがNR'であって、R'は水素原子 である特許研求の範囲第1項記載の超額隔。 (3)複穀労呑族高分子化合物が繰り返し単位



を有する特許請求の範囲第1項記載の組存機。

(4)推索芳香族精造

$$-\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\} R$$

(式中、XはNR', S, O, SeおよびTeからなる部から選ばれた基で、R'はH, 芳春族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳春族基、複素芳香族基、偽和もしくは不飽和脂肪羰基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を主要領点契款とする組織膜で、譲遠層は1もしくはそれ以上の単層からなるか、譲単層の1もしくはそれ以上を含有する積度多層からなる組得感が固体物質に沈澄された複合体。

(5) 超帯膜の複素原子のXがNR'であり、R'は水 素原子である特許請求の範囲節4項記載の超符段

特問昭62-183881(2)

旋苗であり、NH』およびXH蕗は芳香族校上に

オルソ位に闘挽されている〕1もしくはそれ以上 の芳香族アミン・単量体を含有する水溶液の設面に 顧陽し、反応を適めしめることを特徴とする

(太中、XはNR', S, O, SeおよびTeか

らなるボから近ばれた抜で、R'はH, 芳香族苗 もしくは腐助族抜であり、Rは芳香族語、複瀬芳

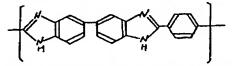
香族基、畑和もしくは不飽和脂肪族基である) を含有する複潔芳香族高分子化合物を有する超薄

蕗で、旋滓蕗は1もしくはそれ以上の単層からな るか、旋単層の1もしくはそれ以上を含有する稜

推断芳香族标迹

が固体物質に沈着された複合体。

(6)推劃労吞設高分子化合物が繰り返し単位



を有する超階関である特許請求の範囲第4項記載 の複合体。

- (7)固体物質が半導体である特許語求の範囲節4項 記載の複合体。
- (8)半退体がゲルマニウムである特許請求の範囲第7項記載の投合体。
- (9)労君族基、投資労会族基、増和もしくは不慎和 虚助核基あるいはその混合物を有すアルデヒド早 量体もしくはアルデヒド車量体誘導物質を、

の式で表わされる(式中、Arは芳香族基、Xは NR'、S、O、SeおよびTeからなる部から 遊ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは配助 月多層である組稼譲の製造方法。 (10)アルデヒド単量体誘導物質が

C H₃(C H₂) ■ N = C H R C H = N (C H₂) ■ C H₃ . 式中、m は 0 も しくはそれ以上大きい熱数であり、 R は芳香族様、福寿芳春族様、始和も しくは不飽

和周訪務基又はこれらの基合物である特許語求の 範囲 9 記載の製造方法。

(11)アルデヒド単量体誘導物質が

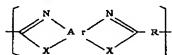
CH₂(CH₂) nN = CHRCH = N(CH₂) nCH₂ 式中、Rは芳春様を含有し、mは0もしくはそれ 以上の整数である特許語求の範囲 1 0 記載の製造 方法。

(12)アルデヒド単量体誘導物質がジヘキシルテレ フタルアルジミンである特許請求の範囲!1記載 の事法方法。

3. 発明の静韻な説明

厳業上の利用分野

この発明は



(式中、Arは芳香族枝、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる郡から選ばれた基で、R'はH、芳香族基準もしくは脂肪族基であり、Rは

芳香族基、 複楽芳香族基、 数和もしくは不飽和脂肪族基である) の論り返し単位を含有する複業芳香族高分子化合物を含有する超減単層および積層された多層際に関するものである。

この発明は推案芳香胺高分子化合物の重縮合合成法、また合成された複素芳香胺高分子化合物を単層で、又種層された多層の形態で遊択された支持体に沈澄する方法に関する。

本発明はこれまで得ることのできなかった **彦**さ を有する推測が香族部分子化合物単層および多別 に関する。

語句の定義

本明師書における「単層」なる語句は、1) 単量体もしくは単量体溶液を水溶液下層に展開したとき得られる、水性下層の設画上の臨(フィルム)を指すか、2) 上記展開単量体単層を本発明により下層と反応させたとき得られるポリマー醇(フィルム)を指す。

「単層」なる語はまた下別表面上の上記単層に、 また該単層が支持体に移転された後のものにも遊

特閒昭 62-183881 (3)

用される。単層の厚さは20ナノメーターより小である。単層において、単分子が該単層の厚さに わたっている場合、該単層は「単分子層」と呼ぶ ことができる。女特体上に単層を1層づつ移転し、 銀ねられたものを多層と呼ぶ。

「アルデヒド単量体 辞 恋物 型 (前 型体)」 なる 語は本発明により適当な下層水溶液上に展開した ときにアルデヒド単量体を生成し得る化合物を指 す。

従来技術及び発明が解決しようとする問題点

本明観客に記載されたポリベンズイミダゾール、ポリオキサゾール、ポリチアゾールのような複素 芳香協姦分子化合物や、それらから得られた酸は 公知であるけれども、1 m より少ない厚きの均 一で良く関数された酸はこれまで製造されたこと はなかった。

複素芳香線高分子化合物の溶酸相、固相および 液相での合成は公知の事柄である。この技術の最近の報告はE. W. Neuse「アドバンシズ・イン・ポリマーサイエンス(Advances

romotecules)」1981、14卷、909~915頁、 J. P. Wolfe, B. H. Loo, F. E. Arnold, 网誌、1981、14卷、915~920頁、

R. C. Evers, F. E. Arnold, T. E. Helminlak, 同誌、1981、14 若、925~930頁およびB. W. Neuse, M. S. Loonat, 同誌、16春、128~136頁(1983). 複素芳香族成合体は融点が高いことと、低い溶解度という点がその特徴である。これらの特性ゆえに複素芳香族高分子化合物の組球臨はこれまで得られなかったのである。

またこれまで超離早間や単分子房ポリマーは知られていたが、それらは本発明の目的である主観に複素芳香族構造を持つものでなく、設主観に復素芳香族構造を有さないものに限られていただけでなく、展開港級中に可溶性であるか、ぶら下っている長アルキル側値を有する高分子を有するものに限られていた。次の文献が高分子化合物単層および多別の領域における従来技術の代表的なも

in Polymer Science)」, 47碧. 1~42頁(1982)やJ. P. Critchl ey、「ディー・アングヴァンテ・マクロモレキュ ラーレ・ヘミー (Dia Angewandte Makromolecular Chemiej . 108/110段、41~80頁(1982) というようなものである。複奏芳香族高分子にお ける従来技術の代表的文獻はY. Iwakura, K. Uno. Y. Imel「ジャーナル・オブ・ ポリマー・サイエンス(Journal of Polymer Science) jPartA. 2者、2605~2615頁(1954)、J. Higgins, C. S. Marvel, 同誌、 PartA-1,8春、171~177夏(19 70), H. Vogel, C. S. Marve 1, 同誌、Vol. L, 511~539頁(19 51), H. Vogel, C. S. Marve l, 同誌、PartA, 1巻、1531~154 [頁(1963)、 J. F. Wolfe, F. E. Arnold, 「マクロモレキュールズ(Mak

のと考えられている。

R. Ackerman等、「コロイド・ジャー ナル、ジャーナル・オブ・ポリマー(Kollo id-z. z. Polym.)」、2249卷、 1118 (1971)、 A. Camel等「ジャ ーナル・オブ・ポリマー・サイエンス(J. Po lym, Sci.)」、PtA-1,10卷、2 061 (1972). M. Putermen \$ 「ジャーナル・オブ・コロイド・インターフェイ ス・サイエンス (J. Colloid · Inte rface Sci.)」、47卷、705頁 (1974)、 R. Ackerman等「マク ロモレキュール・ケミストリイ(Makromo 1. Chem.)」、175卷、699頁(19 74)、 A. Dubault等「ジャーナル・ オブ・フィジカル・ケミストリィ (J. Phys. Chem.)」、79卷、2254頁(1975)。 BanerjeeおよびJ. Lando「シン・ ソリド・フィルムズ (Thin Solid F ilms)」、68卷、1頁(1980)、

特開昭62-183881 (4)

D. R. Day Stuff. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリー(Makr omol. Chem.) j 180卷、1059頁 (1979). B. Tieke, V. Enke lmann, H. Kapp, G. Lieser & よびG、Wegner「インターフェイシャル・ シンセーシス (Interfacial Syn thesis)、皿巻、リーセント・アドパンシ ズ(Recent Advances)」Mar cel Dakker, New York, 19 K. Fukuda, Y. Shibasa ki, H. Nakahara (ジャーナル・オブ・ マクロモレキュラー・サイエンスーケミストリイ (J. Makromol, Sci. - Chem.) A 1 5 物、9 9 9 (1 9 8 1) およびT. Fol da, L. Gross, H. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリイ・ラピド・ コミュニケーション (Makromol. Che m., Rapid Commun.)」、3書、 167頁(1982)。これらの文献は全てビニ

ル基、アクリル基やジアセチレン基のような致合可能な基を有する長額脂肪族両親維性物 (amphiles)の致合に関するものである。これらの取合は遊離基礎構を介して退行する付加致合である。得られる高分子化合物膜は原料単量体の脂肪族の性質を保持している。

本着明の目的たる高分子化合物膜とその製造方法は、高分子化合物単層及び参層の領域における 従来技術と次の点で異なっている。

1)本勇明の目的である威は全芳香族性のものも可 館である。

2) 本発明方法によれば、本明和書に記載された殿 関可能な単量体はそれらに付いた題助族類を有す ることができるが、これらの顧助族類は最終的な 生成陰からは排除される。

3)本発明の目的たる取合方法は総合型混合である。 先の出願(特願昭 5 9 ~ 2 2 9 0 0 3 号)において、本発明者は重合イミンの超薄膜について関 示した。本発明はどんな理論にも束縛されないが、 本明細巻に開示された複素芳香族高分子超薄膜を

製造する機構は、酸化的類化脱水素によってイミン中国体を結由して目的とする複素芳香族高分子 化合物稼媒へと進むと考えられる。

上述の如く、複素芳香族高分子化合物を含有する均一な組織膜は今まで得られていなかった。 展園 溶成中に溶解せず、また長銀アルキル側銀を有さない高分子化合物からなる超溶膜も又得られていなかったのである。

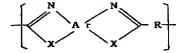
問題点を解決するための手段

本最明はこれまで得られていなかった長頭アルキル側鎖を有さない新規複素芳谷族高分子化合物を含有する超薄単層および積短多層膜を提供するものである。

上記模案労各族高分子化合物は本発明の目的でもある方法によって製造することができる。 即ち 展題可能なアルデヒド単量体もしくはアルデヒド 単量体誘導物質(前駆体)と、芳香族アミン単量体を含有する下層溶液とを用い気/液界面で複楽芳香度高分子化合物を合成することも提供するものである。

即ち、本発明は、

1) 推潢芳香按梯边



[式中、Arは芳香馥核、XはNR′、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R′はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複瀬芳香族基、飽和(アルキレン基)もしくは不飽和脂肪族基(オレフィン系基、アセチレン系基)である]

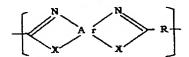
を含有する複素芳む族苗分子化合物を主要構成要素とする超審膜で、靺鞨族は1もしくはそれ以上の単層からなるか。該単層の1もしくはそれ以上を含有する程度多層からなるものであることを特徴とする超磷酸、及び

2) 芳香族基、趙素芳香族基、趙和もしくは不飽 和脂肪族基あるいはその混合物を有すアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質を、

特開昭62-183881 (5)

Han NHa Ar

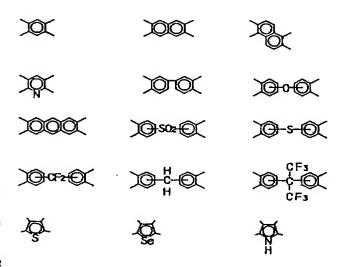
の式で扱わされる 【式中、Arは芳香複鉱、XはNR'、S、O、S。およびT。からなる群から 選ばれた話で、R'はH、芳香複鉱もしくは頭筋 複結であり、Rは芳香複鉱、複素芳香複鉱、飽和 もしくは不飽和脂肪複鉱で、NHュ およびXH 菇 はそれぞれ芳香複核上に位置する】 1 もしくはそ れ以上の芳香銭アミン単量体を含有する水溶液の 製面に展開し、反応を進めしめることを特徴とす る、複素芳香複構造



(式中、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R'はH・芳谷族菇もしくは脂肪族基であり、Rは芳谷族基、復典芳母族基、 線和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する復業芳容族高分子化合物を有する超輝

膜で、 該様膜は 1 もしくはそれ以上の単層からなるか、 該単層の 1 もしくはそれ以上を含有する稅 層多層である組積膜の製造方法に関するものである。

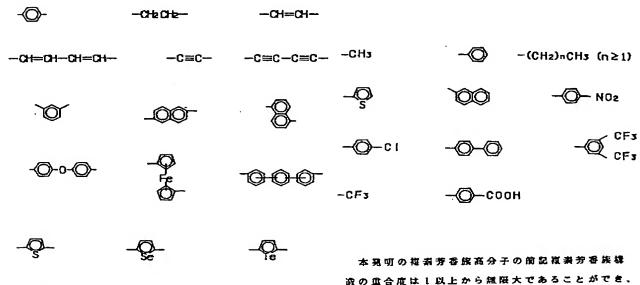
本現明の複雑労番鉄構造の式中、Arである労 番級核としては次のものなどが好適であり、



誠式中、Rは次のものなどを挙げることができる。

又、該式中、XはNH、NR', S, O, Se, T a であるが、NR'のR'は次のものなどが挙げられる。

通信は10~200、好ましくは20~100で



ある.

特開昭62-183881(8)

本発明によれば複瀬芳春族高分子化合物は低ノ 該界面における重観合によって合成することがで き、該重組合も又、本発明の目的である。この重 総合に用いる原料化合物は展開可能なアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体認識物質(前隔 体)および芳香族アミン単垂体である。

アルデヒド単量体誘導物質(前塵体)は、好ましくは、目的とする多官能アルデヒドとアルキルアミンの融合により製造されるシッフ塩基である。用いられる目的とする多官能性アルデヒドの例は、テレフタルアルデヒド、イソフタルアルデヒド(ジカルボキサルデヒドとも登う、以下同じ)、5ークロロベンゼンー1、3ージアール、5ーメチルベンゼンー1、6ージアール、5ーメチルベンゼンー1、3ージアルデヒド、4・4・スチルベングアルデヒド、マロンアルデヒド、アゾベンゼンー4・4・一ジアルデヒド、ピベンジルー4・4・一ジアルデヒド、ピベンジルー4・4・一ジア

ルデヒド、ナフタレンー1、4 - ジアルデヒド、 ナフタレン-2、6 - ジアルデヒド、ジフェニル エーテル-4、4' - ジアルデヒド、(フェニレ ンジオキシ) ジベンズアルデヒド、ピリゾン-2。 6 - ジアルデヒド、2、4 - ヘキサジエン-1。6 - ジアルデヒド、2、4 - ヘキサジン-1。6 - ジアルデヒド、1、4 - ブチンジアルデヒド、 およびコハク酸アルデヒドである。

使用し得る芳香族アミン単量体の例は次のよう なものである。

本希明の目的たる殿の構成単位たる撰纂芳母族

本発明の目的たる方法はアルデヒド単彙体もし くははアルデヒド単量体の前駆体を、1もしくは それ以上の苦香族アミン単量体を含量する水溶液 **多面に展闢させる。この複複の表面に形成される** 展調層を下層と反応させて目的とする推楽労略族 高分子化合物単層を製造する。

樽られた単層を希望する支持体に、ラングミュ アープロジェット法もしくは水平引上げ法によっ て移転させる。これらは当業者に知られた方法で あり、数種の文献、例えばK。Fukuda,T. Ishii「摩膜"新実験科学建度" 18卷、 "界面とコロイド"(丸巻株式会社、1975)館 6章、439~516頁等に記載されている。

簡単に述べればラングミュアーブロジェット法 は水面における単層を囲いを用いて圧縮すること を含む。通常、この思いは下層を入れてあるトラ フの側部および2つの陰壁でつくられている。圧 望は一定の値に維持される。この風作はワックス 糸およびピストン油によって行なわれるが、今日 ではLauda、協和科学、高橋格提、Joyc・

特開昭62-183881 (8)

ョーしっ e b l e、その他で製造されているような自動化トラフで行われる。一定の表面圧が適用されている間、水平に係たれた支持体は引上げられ、また下層表面を通って沈められる。単位層は引上げ(2-型)、引下げ(X-型)もしくは両温作型(Y-型)の間に蘇支持体に移転される。好ましい引上げ及び引下げ速度は下に記載されている。

水平方式の場合、通常は超長いトラフ、例えば5cmm、長さ200cmのものが使用される。 単層は圧縮され、支持体は表面に対して水平に置かれる。通常、単離障壁が支持体のまわりに置かれ、鎮鍵壁と支持体との間に位置する単層は吸引によって取り設かれる。大いで単層の付着した支持体は表面から引き上げられる。

移動に免立って、この下層は多層を秘想したり 単層を注着させるのにより適した条件とするため に又はその単層を注着させるにより適した条件と するために変えることもできる。この場合、狭い トラフ、軒ましくは煙さ約6mmのものが非常に 好ましい。例えば本発明によれば単層もしくは稚 層された多層における過剰のモノマーの存在を避 けるために孫母水でアミン単量体含有の下層を歴 き換えることが好ましい。

移動させた後、支持体を含有する単位層もしく は種間された多層は所望により熱処理を受けるこ とができる。本発明によれば、この工程は空気中 230でより大なる温度で行われるのが好ましい。 この工程は何らかの理論に京都されているもので はないが、気被界面に形成される膜は目的とする 複楽芳香族構造と、酸化的優化反水楽により相当 する複楽芳香族構造を形成するような方番族アニ ルの両方を含有していると考えられる。この加熱 工程は上記酸化的環化反水素反応を完成へと逸め るものと考える。

本発明によればアルデヒド単量体もしくはその 誘導物質(前駆体)は反応性の下層水箱被の表面に 展開される。水表面上に有機化合物を展開させる 基準は広く知られている(例えばA.W.Ads mson「フィジカル・ケミストリー・オブ・サー

フェシズ (Physical Chemistry of Surfaces) 第4度、Wiley:
New York, 1982:IVæもしくはG.
L. Gaines, Jr., 「インソリュブル
モノ レイヤーズ アト ジ エアー/ウォーター
インターフェイス (Insoluble Monolayersat the Air/Water Interface) Wiley:New

er Interlace)Wiley:New York・1968;第4章を参照されたい)。
すなわち展開するためには、展開される化合物と 水表面との間の相互作用が化合物それ自体の凝集 カに打ち克つだけ充分でなければならない。そうでないと、テレフタルアルデヒドやテレフタル酸のように、その化合物は水表面上で単型をは水面上で取る。有機被体の場合、平衡状態というのは表面上にレンズの形で過剰の 破体が強まった単野と考えられる(A. W. Adams an 「フィジカル・ケミストリー・オブ・サーフェンズ(Physical Chemistry of Surfaces)、第4度

Wiley:New York,1982,106頁)。又、本発明の目的を達するよう展開可能であるために上記化合物は該反応中、表面に存在しているように充分に不溶性かつ不得発性でなくてはならない。

本発明によれば展開可能なアルデヒド単量体、 殊に被状のものが直接用いられ得る、気/披昇面 に展開しないアルデヒド単量体は、本発明に は気/披昇面に展開するアルデヒド単量体 質(前堅体)に変換される。この変換は、好まし くは、目的とするアルデヒド単量体をアルキルア ミンと超合させて対応するアルデヒド単量体 が受(前堅体)、この場合にはアルジミン、を形 成させる。アルキル基はアルデヒド単量体 関(前堅体)が被体となるようなものが好ましい。

本発明によれば本質的にアルデヒド単量体もしくはその展開可能な誘導物質(前駆体)は展開溶媒を用いて適用される。本発明は如何なる理論にも東坡されないが、展開溶媒は目的物たる分子を分離する役員を主に為すので該分子は個々に水汲

面と相互作用することができ速かに平衡に返する。 展昭溶群を使用することにより下層に適用される 化合物の量を製節することができる。展開箱碟の 好ましい特性は公知である (例えばG. L. G a ines. Jr. , 「インソリュブル モノ レ イヤーズ アト リキッドノガス インターフェ イス(Insoluble Monolayer sat Liquid-Gas Interfa ce) Wilay: New York, 1968 を参照されたい。〕。 これら特性としては、 速か に、好ましくは展開5分未満で、磊発するよう充 分揮箱性で水面上に風間したとき安定なレンズを 形成しないこと、展開した化合物を溶解すること、 下層中に本質的に不熔性であることである。 これ らの特性を有する好ましい溶媒としてはクロロホ ルム、トルエン、ペンゼン、ジクロロエタン、ヘ キサンもしくはヘプタンとジェチルエーテルとの

展開される化合物の展開溶成中での好ましい機 度は 0 . 0 0 1 および 0 . 1 盤量%の間の譲渡で

ない材料で、好ましくはフルオロカーボンプラスチックあるいはフルオロカーボン被理金属で出来ている。自動化された定圧-定面積性能のものが望ましいが、表面を支持体上に移動させる間、一定の圧力を保つためには通常のピストンオイルを使用できるので上記の性能は必要欠くべからざるものではない。

あり、この機成によって無の十分な調節ができる。本発明によればアルデヒド型量体もしくはその 前駆体の溶液、好ましくはクロロホルム溶液は、 庭間溶粧の蒸留時にし分子につき最終面積が0。 2 平方ナノメーターより大となるような量で下層 に展開される。反応中、展開分子の面積は一定に 保たれる。

上記下型は高度特製水、好ましくはイオン交換 カラム、活性炭フィルターおよび殴フィルターを 好ましくはこの順序で通す蒸留前段工程を経た後、 満宿した高度の超製水で形成されるのが好ましい。

本意明によれば芳香旋アミン単金体は下層中に好ましくは0.001および0.05モルの間の 速度で溶解される。該下層のpHは3.5~6の 間である。該下層は芳香錠アミン単量体の酸性型 から形成されるのが好ましい。

本発明の目的である魅力法は散穏の市販されているか特性のフィルムパランストラフで行うことができる。 該トラフは好ましくは 1 c m より小なる愛さで、下層と反応せず、また汚染物を放出し

「例えばG。Goldfinger個「クリーンサーフェシズ: その調製及び界面学のための特徴
(Clean Surfaces: Their
Preparation and Charac
teritation for Interfa
cial Studies), Marcel D
ekker: New York, 1970)。 金
励もしくは金属被理支持体は滑浄化され、空気中
約400で存ましくは5分以上、加熱すること
により類水性とされる。半導体はいくつかの公知
法の1つで清浄化される。

本発明によれば第1層の沈着は最も臨界的である。該支持体は好主しくは5~20cm/分の間の速度で単位表面層を透して下層に沈める。この下陸中もしくはその後、ある一定の表面圧、好ましくは15~25mN/m、が単位表面層はは好ましくは15~25両形が開放されることが好ましくは1cm/分より遅いスピードで下層から引き上げられる。表面

特開昭 62-183881 (10)

周の支持体への移動は、通択された定数面圧に対応する数面機における減少を観察することによって監視される。 娘く周の沈稜の節に、第1の単位 間の支持体への付着が熟成、好ましくは 2 時間以上の熟成によって強固なものとされる。 続いての 間は第1周と同様に移転され、好ましい引き上げ 速度は 0 . 5 ~ 2 c m / 分の間である。

本発明の目的物たる複楽芳香級高分子化合物超移域は、このものは本発明の目的たる方法により製造されるが、高い熱安定性、高い硬度、化学的安定性、路媒安定性および透明性といった種々の特別の有用な性質を有する。

作用

本義明の復瀬芳香族高分子化合物超薄膜は、新 現な重合体物質であり、このものは全体に芳香族 性であることができ、これらは特に熱的に又化学 的に安定で、溶媒安定性があり、高い硬度及び透 明性を有する等のすぐれた特性を有する。

上記録を製造する方法は非常におだやかな条件 で行える。これらの特徴があるため、これらの護

確認方法はFTIRスペクトル(フーリェ変換赤 外分光法)と電子吸収スペクトルで行なった。

腰序の関定方法は次のようにして行なった。除合シリカ上の数の序さは下。L。McCrakin。stal.、「ジャーナル・オブ・リサーチ・オブ・ザ・ナショナル・ピューロー・オブ・スタンダーズ(Journal of Research of the National Buraau of Standards)、1963、67A物、363-377可」の方法に従い、馬津モデルEP-10エリブソメーターを用いてエリブソ法によって測定した。随合シリカ支持体の国折率は1、45702であった。4域平均法で行なった。

套施例 1

3,3'ージアミノベンジジンの下層溶液を、2回蓋切した蓋留水に3,2ミリモルの溶液になるようそのテトラヒドロクロライド塩を溶解し、次いで0,1ドカ性ソーダでpHを4,0に調整した。この溶液をフィルムバランストラフに入れ、

支遊例

以下の例において使用されたラングミュアープロジェットトラフはラウダ数のフィルムワーゲであり、200cm×15cm×0.6cmのテフロン被配トラフを有する。エリブソメター測定機はHe-Neレーザー光度の設置された島後EP-10エリブソメーターでつくられたものである。又、この臓の生成食合体(くり返し構造式)の

その怼皮は20℃で平衡に違した。ジヘキシルテ レフタルアルジミンを1.04mMのクロロホル ム密度から最終面積が1分子につき1. 2平方ナ ノメーターとなるまで滴下する。反応は下層温度 を20℃に保って一晩進行させた。跛反応は、頭 の下に2回蒸収した蒸留水81を通過させて終了 させた。得られた版は1メーターにつき20ミリ ニュートンの表面圧力となるまで圧縮し、この圧 カで一晩、維持した、該膜は絞いてカルシウムフ ルオライド(CaFa)板上に沈若させたが、この カルシウムフルオライド板はまず磁酸/30%過 世化水素(4:1 v / v)中で洗浄、鋭いて大量の 2回基礎した蒸留水で洗浄したものを用いた。鎮 CaF2板を水平に10cm/分で膜を貫いて沈 めることにより第1周を移転させ、絞いて政板を 0.5 cm/分で引き上げた。この板は2時間脇 に図さ、その依沈潜を第1層と同じ引下げ、引上 け速度で続けた。移転は初めは引上げの時に生じ る。20層を有する多層膜のFTIRスペクトル は第1回の一番上に示すとおりである。空気中で

特開昭 62-183881 (11)

10分回、250℃で熱処理をした後の20層多層のスペクトルは第1回の高中のものである。

カルシウムフルオライド板と同じ方法で、殴合シリカプレートに水表面から好が移転される。このようにして得られた多層の熱処理的 (得られたそのまま) のもの、空気中で10分面250℃の加熱処理したものの各々の電子スペクトルを節2図に示した。

繰り返し単位が

であることは、FTIRスペクトルにおける1450 (c m⁻¹) 及び1290 (c m⁻¹) の吸収によって、また電子スペクトルの370 n m吸収によって独居した。

Y, Iwakura, K. Unostuy. I mailジャーナル・オブ・ポリマーサイエンス (J. Polym. Sci.) J. Part A. 1964.2605~2615頁に記載された方 法にしたがい、ポリリン酸中ジメチルテレフタレー トと3、3′ーペンジジンからポリ〔1、4ーフェ ニレンー5,5'(6,6')ーピペンズイミダゾー ルー2、21ージイル)試料を製製した。0.8 d L/g (30°) の確競中固有粘度を有する生 成盤合体を3重量%のLiClを有するジメチル ホルムアミドに铬解した。この搭被をガラススラ イドにひろげ、溶媒は真空オープン中100℃で 乾燥することによって酸去した。該膜は滑浄な水 面に浮かべ、そこに聞くことによってLICIと 残存DMFを輸去せしめる。該腹をカルシウムフ ルオライド板上にのせる。このものは第1因の一 掛下に示すFTIRスペクトルを与える。

実施例 2

融合シリカ上に15月の形態で喫を形成する外 は実施例1の方法をくり返した。該膜の屈折率お

次いで得られた1cmの巾の牌を通して1cm巾 のガラススライドに引張ることによって新単に行 なえる。このガラススライド上の餌は乾燥させ、 空気中250℃で15分間加熱処理し、次いで3 食量%のLiClを含有している0.3mlのジ メチルホルムアミド中に溶解する。この姿料を3 つのカラム(Shodex AD802/S,A D 8 O 4 / S、およびA D 8 O 6 / S) を直列に つないで設けたWaters Model I50 C ゲル祖透クロマトカラムに注入した。これら のカラムはポリ(エチレンオキシド)及びポリ (エ チレングリコール)を標準として選定されるよう になっている。ジメチルホルムアミド/3里量% LiClを用いて烙出を行なった。この実施例で 得られたポリベンズイミダゾールは分子量 2 4 . 000(重合度=60)のピークを有しており、数 平均分子量は8,000、盘量平均分子量は14 0、000であった。ゲル浸透クロマトグラフ法 で題定され決定された固有結度は0、2であった。 比較何1

よび厚さは、加熱処理前で各々1.80 および1.73 n m であり、加熱処理後は各々1.79 および23.3 n m であった。

実施例3

労香族アミン塩酸塩として 2. 5 ージアミノー 1. 4 ーペンゼンジチオールジ塩酸塩を用いる外は実施例 1. の方法をくり返した。得られた酸はカルシウムフルオライド板上に形成し、空気中 2.5 0 ℃で 1.5 分面熱処理をした。その結果、繰り返し単位

を有する組存高分子職が得られた。

実施例4

芳香線アミン塩酸塩として4、6 ージアミノー
1、3 ーペンゼンジオールジ塩酸塩を用いる外は
実施例1の方法をくり返した。多層をカルシウム
フルオライド板上に租房し、空気中250℃で1
5 分間熱処理をした。その結果、繰り返し単位

特開昭 62-183881 (12)

を有する超稼菇分子膜が得られた。 実旗例 5

芳谷族アミン塩酸塩として4、6ージアミノー1、3ージセレニルペンゼンジ塩酸塩である外は 実施例1の方法を繰り返した。フッ化カルシウム 板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分 関加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超線高分子頭を得た。

実施例6

芳香酸アミン塩酸塩として4.6ージアミノー1.3ージアルリルベンゼンジ塩酸塩である外は実施例1の方法を繰り返した。ファ化カルシウム板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超薄高分子順を得た。

又本発明の該高分子化合物の製造方法も新規であり、非常におだやかな条件で行なうことができ、 確々の複楽芳香族高分子化合物の超薄膜の単層積 層物、複合体が自在に容易に得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は実施例1により製造された多層の、加熱的(上)、加熱後(中)および比較例1により 製造された膜(下)のFTIRスペクトルを示す。 第2回は実施例1により製造された多層膜の、加 熱処理前(符られたそのまま)、空気中250℃ 10分間熱処理後のもの。および空気中420℃、 30分間熱処理後のものの電子吸収スペクトルを 示す。

代理人 大多和 明敏

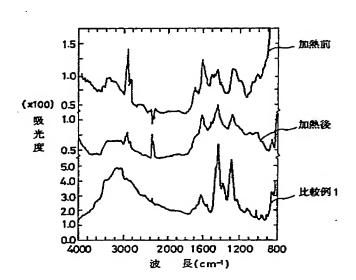
発明の効果

本発明の根蓋芳香族協分子化合物超薄酸は新規な重合体物質であり、このものは全体に芳香族性であることができ、これらは殊に熱的に又化学的に安定で、海媒中での安定性が高く、また高い硬度及び透明性を有する等のすぐれた物性を有する。

上記の特徴があるため、これらの腐は半速体上の、特にInP、CdS、InAsおよびZnS。Sのような天然の酸化物膜の良好な性質を欠いている半速体上の、絶縁膜として有用である。これらの半導体は高い電子移動性、即ち路離壁化化のう物性を有しており、良好な性質の絶縁酸化化物膜がないためにその市場における応用性を阻害している道常のシリコン半速体よりも好ましいものでいる通常のシリコン半速体よりも好ましいもできる。本発明の関は極めて薄いので、これらはMIS

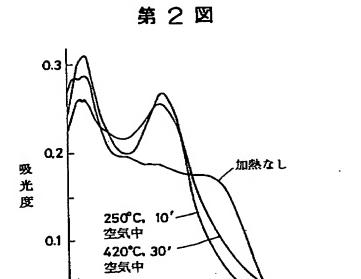
(金属的線物半導体)型FET(表面電解効果) トランジスターにおける絶縁層として広く広用又 は利用できるものである。

第 | 図



持開昭62-183881 (13)

700



450

波

長 (nm)

0.01